

「令和2年度革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業」についてのQ&A

令和2年度12月25日

	ご質問	回答
1	パワーデバイス領域の対象となる半導体材料に制限はあるのか。	制限はございません。 例えば、GaNやSiC、Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 、ダイヤモンド等の次世代パワー半導体を対象としています。
2	令和2年度内に設備等の調達に間に合わない場合には、その予算の繰越は可能か。	本事業は令和2年度補正予算による委託事業のため、令和2年度に執行していただくことが原則になります。例外として、契約後、やむを得ない事情があった場合には繰越を行うことができますが、事業の遅延について、財務大臣の承認を経て、最長翌年度末までの繰越を認める場合があります。繰越に当たっては、財務当局との協議が必要となることから、事象が発生した際には速やかに担当まで御相談ください。
3	応募から研究開発終了に至るまでの間に定年退職で役職が変わる場合（例えば、教授から特任教授など）は、応募対象者となりうるか。	退職後も日本国内の研究機関に所属し、研究をそのまま実施できる役職の就任が見込まれる場合は応募可能です。
4	パワーデバイス領域以外の公募はいつごろ開始されるのか。	他の領域の公募については、追ってお知らせいたします。
5	別途公募予定となっている他の研究領域に対しても応募することは可能か。	可能です。
6	別途公募予定となっている他の研究領域の予算規模について知りたい。	各領域の予算規模については、今後別途公募する際に公表します。
7	高温高圧熱処理装置の整備は必須か。	高温高圧熱処理装置の整備以外にも、パワーデバイスの特性・信頼性の向上に貢献する設備であれば公募対象です。
8	公募要領5ページに、イオン注入によって生じる結晶欠陥やドーパントの電気的失活化等を軽減するための設備と記載されているが、そのような課題がないパワー半導体の場合はどうなるのか。	公募要領の記載はあくまで一例にすぎません。各パワー半導体のボトルネック課題に沿った研究計画を提示してください。